

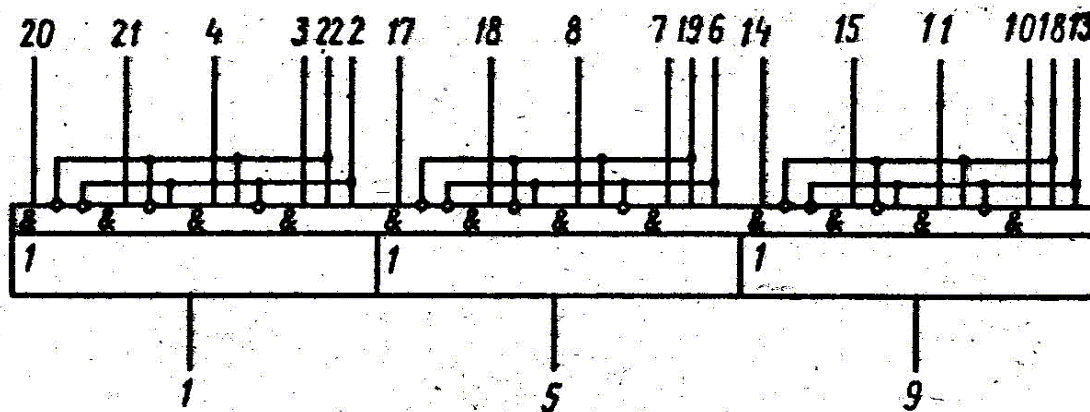
# К501КН1П, КР501КН1

Микросхема представляет собой строенный четырехходовый кодовый ключ. Содержит 325 интегральный элемент.

Корпус прямоугольный пластмассовый 209.24-3 и 2130.24-1, масса не более 3,6 г.

Выводы: общий — 12; —Uип<sub>1</sub> — 24; Uип<sub>2</sub> — 23.

Напряжение источника питания: Uип<sub>1</sub> = —12 В±10%; Uип<sub>2</sub> = —27 В±10%.



## Электрические параметры

Входное напряжение низкого уровня	> -2 В
Входное напряжение высокого уровня	< -8,5 В
Выходное напряжение низкого уровня	> -1 В
Выходное напряжение высокого уровня	< -9,5 В
Напряжение помехи, не более	1,0 В
Входной ток высокого уровня	< 0,4 мкА (< 1,8 мкА)*
Ток потребления Iпот <sub>1</sub> , не более	5,2 мА
Ток потребления Iпот <sub>2</sub> , не более	3,6 мА
Мощность потребления, не более	180 мВт
Время задержки сигнала	< 1,6 мкс
Время перехода микросхемы из состояния «0» в состояние «1»	< 2,3 мкс
Время перехода микросхемы из состояния «1» в состояние «0»	< 2,2 мкс (< 4 мкс)*
Коэффициент разветвления	30
Емкость выводов (f = 125 кГц) :	
2, 6, 13	6 пФ
3, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 21	4 пФ
11, 16, 19, 22	5 пФ

\* по некоторым источникам

## Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации

Напряжение положительной полярности на любом выводе, не более	0,3В
Напряжение источника питания:	
Uип <sub>1</sub> , не менее	—20 В
Uип <sub>2</sub> , не менее	—30 В
Входное напряжение, не менее	—30 В
Выходное напряжение, не менее	—20 В
Допустимое значение статического потенциала на выводах, не более	30 В

## Условия применения

Температура окружающей среды	-45...+70 °С
Многократное циклическое изменение температур	-45...+70 °С
Относительная влажность воздуха при +25 °С	98%
Синусоидальная вибрация (1-600 Гц)	10 g
Многократные удары с ускорением	75 g
Линейное ускорение	25 g

Допускается применение ИС при токе нагрузки 0,4 мА в состоянии «0» на выходе при изменении выходного напряжения «0» до —2 В. Допускается ток нагрузки до 1 мА в состоянии «0» без регламентации уровня. Допускается выходное напряжение —6,5 В в состоянии «1» при подключении резистора Rн = 13 кОм между контролируемым и общим выводами микросхем.